

**عنوان مقاله:**

محاسبه پذیرفتاری مغناطیسی خوشه ملکولی مغناطیسی Mn۱۲ با درنظرگرفتن برانگیختگی های چهارقطبی

**محل انتشار:**

دوفصلنامه اپتوالکترونیک، دوره ۳، شماره ۱ (سال: ۱۳۹۹)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

**نویسندها:**

یوسف یوسفی - دکتری نخصصی، فیزیک، دانشگاه پیام نور

رامین شیری - استادیار، اپتیک و لیزر، پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

**خلاصه مقاله:**

در این مقاله، وابستگی دمایی پذیرفتاری مغناطیسی خوشه ملکولی M<sub>n</sub>۱۲ در میدان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون برای محاسبه پذیرفتاری مغناطیسی، فقط برانگیختگی های دوقطبی در محاسبات لحاظ می شد. اما با توجه به عدد اسپین این خوشه ملکولی و برای به دست آوردن دقت بالاتری در محاسبات، باید برانگیختگی های چندقطبی بیشتری را در محاسبات وارد کرد. به همین منظور در این مقاله در محاسبات مربوط به پذیرفتاری مغناطیسی ملکول، علاوه بر برانگیختگی های دوقطبی، برانگیختگی های چهارقطبی نیز لحاظ شده و نمودارهای مربوط به آن رسم گردیده است. محاسبات نشان می دهد که نتایج حاصل شده در وضعیتی که برانگیختگی های چهارقطبی لحاظ شده، با نتایج تجربی همخوانی بهتری دارند.

**کلمات کلیدی:**

خوشه ملکولی مغناطیسی، پذیرفتاری مغناطیسی، انرژی کلاسیک، برانگیختگی چندقطبی، مقدار چشم داشتی

**لينک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:**
<https://civilica.com/doc/1844917>
